

Excerpt Translation

Reference Number OG004500

Mailing Number 057844

Mailing Date 2003 February 25 1/2

OFFICIAL NOTICE OF REASON FOR REJECTION

Patent Application Number	2001 Patent Application No.089851
Date of Draft	2003 February 18
JPO Examiner	TASHIRO YOSHINARI 9448 4R00
Agent of Patent Applicant	ONISHI KENJI
Applied Articles	Article 29 Paragraph 2 , Article 37

This application is to be rejected for the following reason. The argument should be submitted within 60 days of the mailing date of this official notice.

REASON

2. The invention in accordance with the following claims of this application shall not be granted a patent on the basis of Section 29 (2) of the Patent Law, because the invention could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains on the basis of an invention or inventions referred to inventions which were described in the following publication distributed in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application.

As to Reason 2)

Claims 38 and 39

Cited Documents 1 and 2

Remark:

Refer to lines 44 - 45 in the 6th column in Page 4 of the cited document 1 and spots related thereto.

It is perceived that in the invention described in the cited document 1, the execution of sealing of only a main surface of a semiconductor wafer with a resin could be suitably made by a person skilled in the art on the basis of the description (lines 2 - 3 in the 11th column in Page 7 and spots related thereto) of the cited document 2.

It is well known that upon placement of the semiconductor wafer, its placement surface is brought into uneven shapes (its basis: refer to microfilms or the like disclosed

in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-21786 and Japanese U.M. Application No. Hei 1(1989)-134648 (Japanese U.M. Application Laid-Open No. Hei 3(1991)-73454)).

Claims 47 through 49

Cited Documents 1 and 2

Remark:

Refer to lines 44 - 45 in the 6th column in Page 4 of the cited document 1 and the spots related thereto.

It is perceived that in the invention described in the cited document 1, the execution of sealing of only the main surface of the semiconductor wafer with the resin could be suitably made by a person skilled in the art on the basis of the description (lines 2 - 3 in the 11th column in Page 7 and the spots related thereto) of the cited document 2.

Claim 60

Cited Documents 1 and 2

Remark:

Refer to lines 44 - 45 in the 6th column in Page 4 of the cited document 1 and the spots related thereto.

It is perceived that in the invention described in the cited document 1, the execution of sealing of only the main surface of the semiconductor wafer with the resin could be suitably made by a person skilled in the art on the basis of the description (lines 2 - 3 in the 11th column in Page 7 and the spots related thereto) of the cited document 2.

List of Cited References

1. Japanese Patent Publication Laid-Open No. Hei 9 (1997)-219421
(Unexamined Patent Publication No. Hei 9(1997)-219421)
2. Japanese Patent Publication Laid-Open No. 2000-349114
(Unexamined Patent Publication No. 2000-349114)

* * * * *

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2001-089851
起案日 平成15年 2月18日
特許庁審査官 田代 吉成 9448 4R00
特許出願人代理人 大西 健治 様
適用条文 第29条第2項、第37条



この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

- 1) この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。
- 2) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

S i S C

理由1) について

請求項1乃至60

備考

提出期限
4. 月28日

1. 請求項60に係る発明を特定発明とした場合、請求項1乃至17に係る発明、請求項18乃至24に係る発明、請求項25乃至26に係る発明、請求項27乃至29に係る発明及び請求項35に係る発明は、半導体ウエハとは異なる技術分野に属する発明であるから、特許法第37条各号において規定される関係を有していないものと認められる。

2. 請求項60に係る発明を特定発明とした場合、請求項60に係る発明における半導体ウエハを製造するためには、「主表面上に形成された複数の半導体素子と、前記複数の半導体素子を区画し該表面上を直線上に横断する複数のグリッドラインと、前記主表面上を覆う樹脂層とを備えた半導体装置製造用の半導体ウエハにおいて、この半導体ウエハの外周部では、前記複数のグリッドラインの端部が前記樹脂から露出」するための製造工程を備えることを要件とするものと認められる一方で、請求項30乃至34、36乃至37に係る発明、請求項40乃至

41に係る発明、請求項42乃至46に係る発明及び請求項50乃至59に係る発明は、いずれも上記請求項60に係る発明における半導体ウエハを製造するための製造工程を備えるものとは認められないから、特許法第37条各号において規定される関係を有していないものと認められる。

理由2)について

請求項38乃至39

引用文献1及び引用文献2

備考

引用文献1の第4頁第6欄第44行乃至第45行及びその関連箇所を参照のこと。

引用文献1に記載の発明において、半導体ウエハの主表面のみに樹脂封止を実施することは、引用文献2の記載（第7頁第11欄第2行乃至第3行及びその関連箇所。）に基づき当業者であれば適宜になし得るものと認められる。

また、半導体ウエハを載置する際に、載置面を凹凸形状とすることは周知（その根拠については、例えば、特開2000-21786号公報及び実願平1-134648号（実開平3-73454号）のマイクロフィルム等を参照のこと。）。

請求項47乃至49

引用文献1及び引用文献2

備考

引用文献1の第4頁第6欄第44行乃至第45行及びその関連箇所を参照のこと。

引用文献1に記載の発明において、半導体ウエハの主表面のみに樹脂封止を実施することは、引用文献2の記載（第7頁第11欄第2行乃至第3行及びその関連箇所。）に基づき当業者であれば適宜になし得るものと認められる。

請求項60

引用文献1及び引用文献2

備考

引用文献1の第4頁第6欄第44行乃至第45行及びその関連箇所を参照のこと。

引用文献1に記載の発明において、半導体ウエハの主表面のみに樹脂封止を実施することは、引用文献2の記載（第7頁第11欄第2行乃至第3行及びその関連箇所。）に基づき当業者であれば適宜になし得るものと認められる。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項38乃至39、47乃至49及び60以外の請求項に係る発明については同法第37条以外の要

件についての審査を行っていない。

引用文献等一覧

1. 特開平9-219421号公報
2. 特開2000-349114号公報

先行技術文献調査の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/56

この先行技術文献調査の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

問い合わせ先

特許審査第三部（電子素材加工）

TEL 03(3581)1101 x. 3470

FAX 03(3580)6905